

BD544 (3CD544)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于中功率放大。

Purpose: Medium power amplifier applications.

特点:集电极电流大, 耗散功耗大, 与 BD543 (3DD543) 互补。

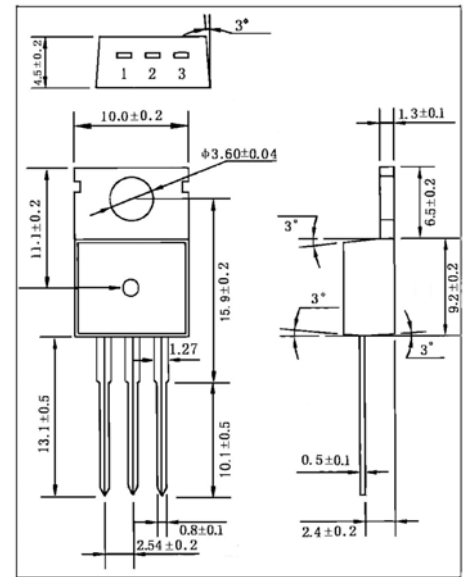
Features: High I_c , high P_c , complement to BD543 (3DD543).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit	参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CE0}	BD544	-40	V_{EB0}	-5.0	V
	BD544A	-60	I_c	-8.0	A
	BD544B	-80	I_{CM}	-10	A
	BD544C	-100	P_c	2.0	W
V_{CE0}	BD544	-40	$P_c (T_c=25^\circ\text{C})$	70	W
	BD544A	-60	T_j	-55~150	$^\circ\text{C}$
	BD544B	-80	T_{sag}	-55~150	$^\circ\text{C}$
	BD544C	-100	T_L	260	$^\circ\text{C}$

T0-220

单位 :mm



引脚: 1 B 2 C 3 E

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit	
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max		
V_{CE0}	BD544	$I_c=-30\text{mA}$	$I_B=0$	-40		V
	BD544A			-60		
	BD544B			-80		
	BD544C			-100		
I_{CE0}	BD544/BD544A	$V_{CE}=-30\text{V}$	$I_B=0$		-0.7	mA
	BD544B/BD544C	$V_{CE}=-60\text{V}$	$I_B=0$			
I_{CES}	BD544	$V_{CE}=-40\text{V}$	$V_{EB}=0$		-0.4	mA
	BD544A	$V_{CE}=-60\text{V}$	$V_{EB}=0$			
	BD544B	$V_{CE}=-80\text{V}$	$V_{EB}=0$			
	BD544C	$V_{CE}=-100\text{V}$	$V_{EB}=0$			
I_{EB0}	$V_{EB}=-5.0\text{V}$	$I_c=0$			-1.0	mA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-4.0\text{V}$	$I_c=-1.0\text{A}$		60		
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-4.0\text{V}$	$I_c=-3.0\text{A}$		40	200	
$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=-4.0\text{V}$	$I_c=-5.0\text{A}$		15		
$V_{CE(\text{sat})}$	$I_B=-0.3\text{A}$	$I_c=-3.0\text{A}$			-0.6	V
	$I_B=-1.0\text{A}$	$I_c=-5.0\text{A}$			-0.6	V
	$I_B=-1.6\text{A}$	$I_c=-8.0\text{A}$			-1.0	V
V_{BE}	$V_{CE}=-4.0\text{V}$	$I_c=-5.0\text{A}$			-1.4	V

BD544 (3CD544)

